# Низкотемпературное магнитное поведение редкоземельных кобальтитов GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub>

© Н.Б. Иванова\*,\*\*, Н.В. Казак\*\*, С.R. Michel\*\*\*, А.Д. Балаев\*\*, С.Г. Овчинников\*\*,\*\*\*

\* Сибирский федеральный университет, Политехнический институт,
660074 ул. Киренского 26, Красноярск, Россия
\*\* Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН,
660036 Красноярск, Россия
\*\*\* Departamento de Fisica, C.U.C.E.I., Universidade de Guadalajara, Blvd. Marcelino Carcia Barragan 1421,
44430 Guadalajara, Jalisco, Mexico

\*\*\*\* Сибирский федеральный университет, Институт естественных и гуманитарных наук,

660041 пр. Свободный 79, Красноярск, Россия

E-mail: nat@iph.krasn.ru

(Поступила в Редакцию 28 февраля 2007 г.)

Измерены температурные и магнитополевые зависимости статической намагниченности поликристаллических P3M-кобальтитов GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub>. Показано, что в обоих соединениях при температуре ниже комнатной намагниченность в основном обусловлена парамагнетизмом редкоземельных ионов. Обнаружены значительные расхождения в магнитном поведении GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub>, обусловленные различием в строении их электронных оболочек. Магнитное поведение GdCoO<sub>3</sub> близко к поведению совокупности свободных ионов Gd<sup>3+</sup>, тогда как для SmCoO<sub>3</sub> отклонение от свойств свободных ионов очень велико из-за расщепления основного состояния ионов Sm<sup>3+</sup> в кристаллическом поле. Согласно данным по ван-флековской магнитной восприимчивости SmCoO<sub>3</sub>, величина расщепления составляет  $\sim 10$  K.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОФН "Сильные электронные корреляции" и Российского фонда содействия отечественной науке.

PACS: 75.25.+z, 75.20.Ck

#### 1. Введение

Кобальтиты редкоземельных элементов с химической формулой LnCoO<sub>3</sub>, где Ln — лантан или лантаноид (Y, Sm, Gd, Но и т.д.), представляют собой перовскитоподобные кристаллы, которые в течение долгого времени привлекают к себе внимание как материалы, обладающие разнообразными, во многом уникальными физическими свойствами. Среди этих свойств выделяются значительное магнитосопротивление [1], аномалии магнитной восприимчивости [2,3], термоэдс [4-6], теплового расширения кристаллической решетки [7], а также переходы металл-диэлектрик [8-10]. Неослабевающий интерес к оксидам кобальта обусловлен и многообещающими перспективами их практического применения в качестве элементов твердотельных источников питания (SOFCs) [11], гетерогенных катализаторов, кислородных мембран и газовых сенсоров [12]. Значительная термоэдс, наблюдаемая в кобальтитах редкоземельных металлов, позволяет рассматривать их как альтернативу традиционным полупроводниковым термоэлектрическим материалам [13].

Несмотря на полувековую историю изучения кобальтоксидных соединений, вопросы о природе и степени устойчивости как основного, так и вышележащих электронных состояний ионов Co<sup>3+</sup> и в настоящее время остаются предметом дискуссий [14–16]. Ключевой проблемой для РЗМ-кобальтитов является так называемая проблема высоко-, низко- и среднеспинового состояний. Особенностью рассматриваемых оксидов является тот факт, что электронные состояния  $Co^{3+}$ , соответствующие различным значениям спина *S*, почти вырождены, поэтому переход между ними может осуществляться под воздействием температуры или давления. При этом на вопрос о том, какое именно спиновое состояние реализуется в том или ином случае, в данный момент все еще нет однозначного ответа как с экспериментальной, так и с теоретической точки зрения.

Наиболее изученным представителем семейства P3M-кобальтитов в настоящее время является LaCoO<sub>3</sub>. Относительно других членов ряда LnCoO<sub>3</sub> пока имеется недостаточно экспериментальных данных, особенно в области низких температур. В то же время для последующих практических приложений эти соединения нередко оказываются более эффективными, поэтому исследование их свойств также необходимо. В данной работе проведено экспериментальное изучение и сравнение низкотемпературных магнитных свойств двух кобальтоксидных соединений: GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub>. Несмотря на сходство состава, в магнитном поведении этих двух материалов обнаружены существенные различия, обусловленные различием в строении электронных оболочек ионов Gd<sup>3+</sup> и Sm<sup>3+</sup>.

### 2. Образцы и методика эксперимента

Для изготовления поликристаллических образцов в данной работе применен растворный золь-гель метод [9], при котором стехиометрические количества нитратов кобальта и гадолиния или самария растворяются в деионизованной воде, а затем подвергаются сушке при 90°C в течение 6 h. Полученные порошкообразные образцы отжигаются при температуре 300°C на воздухе, прессуются и подвергаются повторному отжигу. Прессованные образцы GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub> имели форму прямоугольных параллелепипедов и размер  $4 \times 2 \times 1$  mm.

Были измерены температурные зависимости электросопротивления при температуре от 80 до 400 К, температурные зависимости статической намагниченности в интервале температур 4.2–300 К, а также магнитополевые зависимости намагниченности при различных температурах и магнитном поле до 70 kOe.

#### 3. Экспериментальные результаты

По данным рентгеновской дифракции исследуемые образцы имеют ромбически искаженную перовскитоподобную структуру с пространственной группой  $P_{bnm}$  [17], что типично для соединений ряда LnCoO<sub>3</sub>. Параметры решетки соответствуют литературным данным [18]. Удельная электрическая проводимость образцов при комнатной температуре имеет достаточно низкие значения порядка  $10^{-5} \Omega \cdot m$  для GdCoO<sub>3</sub> и  $10^{-6} \Omega \cdot m$ для SmCoO<sub>3</sub>. С понижением температуры наблюдается дальнейшее значительное снижение проводимости, так что при низких температурах оба состава могут быть отнесены к диэлектрикам.

Температурные зависимости статической магнитной восприимчивости  $\chi$  и обратной ей величины  $\chi^{-1}$  для GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub> в магнитном поле напряженности H = 1 kOe представлены на рис. 1. Восприимчивость обоих составов монотонно увеличивается с понижением температуры, однако при этом наблюдаются три существенных различия. Во-первых, абсолютные значения восприимчивости SmCoO<sub>3</sub> на два порядка меньше, чем



**Рис. 1.** Температурные зависимости магнитной восприимчивости и обратной ей величины для  $GdCoO_3$  (1, 1') и  $SmCoO_3$  (2, 2') в магнитном поле напряженностью H = 1 kOe. Значения восприимчивости для  $SmCoO_3$  умножены на 100.



**Рис. 2.** Температурная зависимость произведения магнитной восприимчивости на температуру для SmCoO<sub>3</sub> в магнитном поле напряженностью H = 1 kOe. I — эксперимент, 2 — расчет для свободного иона Sm<sup>3+</sup>. На вставке — низкотемпературный участок графика.

для GdCoO<sub>3</sub>. Во-вторых, с ростом температуры восприимчивость GdCoO<sub>3</sub> стремится к нулю, а у SmCoO<sub>3</sub> — к постоянному значению  $\chi_0 = 1.54 \cdot 10^{-3}$  cm<sup>3</sup>/mol. И наконец, для GdCoO<sub>3</sub> температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости хорошо аппроксимируется прямой линией, что указывает на выполнение закона Кюри–Вейсса:

$$\chi = C/(T + \Theta). \tag{1}$$

Это позволяет определить асимптотическую температуру Кюри  $\Theta \approx -6$  К. Значение константы  $C = \mu_{\text{eff}}^2 N_A/3k$ = 6.81 сm<sup>3</sup> · K/mol дает эффективный магнитный момент на формульную единицу  $\mu_{\text{eff}} \approx 7.38 \,\mu_{\text{B}}$ ,  $\mu_{\text{B}}$  — магнетон Бора,  $N_A$  — число Авогадро, k — постоянная Больцмана. В то же время температурный ход обратной магнитной восприимчивости SmCoO<sub>3</sub> существенно нелинеен; следовательно, закон Кюри–Вейсса не выполняется.

Поскольку на рис. 1 температурная зависимость восприимчивости SmCoO<sub>3</sub> выглядит как суперпозиция двух вкладов — обратно пропорционального температуре и температурно-независимого, есть смысл рассмотреть температурную зависимость произведения восприимчивости на температуру, которая в этом случае должна получиться линейной. Эта зависимость показана на рис. 2, откуда видно, что действительно в широком температурном интервале произведение  $\chi T$  ведет себя как линейная функция температуры. Это значит, что магнитная восприимчивость SmCoO<sub>3</sub> может быть представлена в виде суммы двух вкладов: подчиняющегося закону Кюри и температурно-независимого  $\chi_0$ 

$$\chi = C/T + \chi_0. \tag{2}$$

Аппроксимация экспериментальных данных линейной зависимостью дает значение  $C = 2.76 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^3 \cdot \text{K/mol}$  и  $\chi_0 = 1.46 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3/\text{mol}.$ 

Из вставки к рис. 2, где показана самая низкотемпературная часть зависимости  $\chi T$ , видно, что прямая



**Рис. 3.** Кривые намагничивания GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub> при T = 4.2 K. Значения намагниченности для SmCoO<sub>3</sub> умножены на 100.

линия, характеризуемая полученными выше параметрами, имеет излом в окрестности T = 10-11 К и выходит на другой участок, также близкий к линейному. Этот низкотемпературный отрезок прямой линии имеет еще больший наклон (штриховая линия на рис. 2), что дает  $C = 1.68 \cdot 10^{-2}$  сm<sup>3</sup> · K/mol и  $\chi_0 = 2.53 \cdot 10^{-3}$  сm<sup>3</sup>/mol для T < 10 К.

Полевые зависимости намагниченности для обоих образцов линейны в области слабых полей при всех температурах, что характерно для парамагнетиков. Однако в сильных полях линии намагничивания рассматриваемых составов неодинаковы. При T = 4.2 К и максимальном доступном в нашем эксперименте поле 70 kOe намагниченность M(H) GdCoO<sub>3</sub> проявляет тенденцию к насыщению, чего не наблюдается для SmCoO<sub>3</sub> (рис. 3).

## 4. Обсуждение результатов

При обсуждении свойств соединений, содержащих два сорта магнитных ионов, всегда встает вопрос, в какой мере магнетизм того или иного иона формирует экспериментально наблюдаемые свойства. В нашем случае, однако, из экспериментов по структурным изменениям [19], намагниченности и нейтронной спектроскопии [20,21] известно, что при температурах ниже комнатной для соединений LnCoO<sub>3</sub> с Ln  $\neq$  La характерно низкоспиновое немагнитное состояние ионов Со<sup>3+</sup>. Наши данные по статическому намагничиванию также указывают на то, что при температурах ниже комнатной в соединениях GdCoO<sub>3</sub> и SmCoO<sub>3</sub> низкоспиновое состояние ионов Со<sup>3+</sup> фиксировано. Таким образом, за магнетизм соединений GdCoO3 и SmCoO3 при температурах ниже комнатной в основном ответственны редкоземельные элементы. Сказанное справедливо для стехиометрических соединений. При наличии дефицита по кислороду, свойственного РЗМ-кобальтитам, индуцированные дефектами стехиометрии иновалентные ионы кобальта, несомненно, будут давать вклад в намагниченность. Кроме того, даже для ионов, находящихся в немагнитном основном состоянии, магнитная восприимчивость может быть и не равна нулю благодаря наличию поляризационной ван-флековской составляющей, что будет обсуждаться далее.

Свойства, демонстрируемые магнитными ионами, в решающей степени зависят от их окружения, т.е. от величины и симметрии кристаллического поля. Наиболее отчетливо влияние кристаллического поля на восприимчивость можно проследить в тех магнетиках, в которых величина обменного взаимодействия редкоземельных ионов мала по сравнению с кристаллическим полем. К таким соединениям как раз относятся РЗМкобальтиты LnCoO3. В них расщепление энергетических уровней кристаллическим полем по порядку величины составляет 10<sup>2</sup> ст<sup>-1</sup>, что значительно превышает величины обменных, дипольных и других взаимодействий. Однако Gd<sup>3+</sup> в этом смысле является одним из исключений, так как основным состоянием этого иона является S-состояние  $(4f^7, {}^8S_{7/2}, L = 0, S = 7/2),$ которое расщепляется кристаллическим полем только в высших порядках теории возмущений. Поэтому можно ожидать, что магнитные свойства ионов Gd<sup>3+</sup> в GdCoO<sub>3</sub> будут близки к свойствам совокупности свободных ионов. Приблизительно так дело и обстоит в действительности. В эксперименте мы наблюдаем обычный ориентационный парамагнетизм. Тем не менее обращают на себя внимание отрицательное значение  $\Theta = -6 \,\mathrm{K}$  и заметно меньшая величина эффективного магнитного момента  $\mu_{\rm eff} = 7.38 \,\mu_{\rm B}$  по сравнению со значением 7.94 µ<sub>В</sub> для свободного иона, что указывает на наличие слабого антиферромагнитного взаимодействия [17]. Аналогичное поведение магнитных систем, содержащих ионы Gd<sup>3+</sup>, характерно также для оксидных стекол на основе Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [22-25]. Для РЗМ-кобальтитов небольшие отрицательные парамагнитные температуры Кюри имели место в соединениях La<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>CoO<sub>3</sub> [26]. Авторы [26] отнесли этот экспериментальный факт на счет нестехиометрии по кислороду, свойственной рассматриваемым соединениям.

Уменьшение по сравнению с теоретическим магнитного момента иона Gd<sup>3+</sup> может быть вызвано также расщеплением его основного состояния — октета  ${}^{8}S_{7/2}$ в кристаллическом поле. Если бы основным состоянием ионов с наполовину заполненной 4*f*-оболочкой было чистое состояние  ${}^{8}S_{7/2}$ , то отличным от нуля было бы только зеемановское взаимодействие. Однако даже для свободного атома или иона имеется влияние промежуточной связи, благодаря которой к основному состоянию примешиваются вышележащие и основное состояние приобретает форму [27]

$$(1 - \alpha^2)^{1/2} \cdot {}^8S_{7/2} + \alpha \cdot {}^6P_{7/2} + \dots,$$
(3)

*а* — параметр смешивания. Под действием поля лигандов это состояние претерпевает расщепление, однако как теоретическая, так и экспериментально наблюдаемая его величина для  $Gd^{3+}$  не превышает 1 К [28].

Что касается свободного иона Sm<sup>3+</sup>, то его электронная конфигурация  $4f^5$ , основное состояние — мультиплет  ${}^6H_{5/2}$  (L = 5, S = 5/2). Характерной особенностью этого иона является относительная близость к основному первого возбужденного состояния  ${}^6H_{7/2}$ . Разность энергий этих состояний для свободного иона составляет примерно 1000 сm<sup>-1</sup>. Примешивание волновых функций возбужденных состояний к основному приводит к возникновению нового вида парамагнетизма — поляризационного парамагнетизма ван Флека, особенно ярко выраженного у ионов Sm<sup>3+</sup> и Eu<sup>3+</sup>.

В ван-флековских парамагнетиках магнитная восприимчивость  $\chi$  может быть представлена в виде суммы трех слагаемых:

$$\chi = \chi_c + \chi_p + \chi_d, \qquad (4)$$

где  $\chi_c$  — восприимчивость, обусловленная обычным ориентационным парамагнетизмом ионов, находящихся в основном состоянии,  $\chi_p$  — поляризационная ван-флековская восприимчивость,  $\chi_d$  — компонента, описывающая диамагнитный вклад электронных оболочек. Поскольку диамагнитная составляющая, как правило, невелика, будем считать ее пренебрежимо малой.

Формула для молярной ван-флековской восприимчивости имеет вид [29]

$$\chi_p = 2N_A \sum_{n'=1} \frac{|\langle n | \hat{M}_z | n' \rangle|^2}{\Delta'_n}, \quad \Delta'_n = E_{n'} - E_n.$$
 (5)

Здесь  $N_A$  — число Авогадро,  $M_z$  — *z*-компонента магнитного момента,  $E_n$  и  $E_{n'}$  — энергии основного и возбужденного состояний. Считается, что поле направлено по оси *z*. Вклад каждого члена в сумме (5) тем больше, чем меньше разность энергий  $E_{n'}-E_n$ . Если нет теплового возбуждения вышележащих уровней, то  $\chi_p$  не зависит от температуры.

Для иона Gd<sup>3+</sup> разность энергий между основным  ${}^{8}S_{7/2}$  и первым возбужденным  ${}^{6}P_{7/2}$  состояниями составляет примерно 30 000 cm<sup>-1</sup>, поэтому поляризационная восприимчивость пренебрежимо мала, и мы наблюдаем только кюри-вейссовский ориентационный вклад (рис. 1). У ионов Sm<sup>3+</sup> обе компоненты восприимчивости по величине сопоставимы друг с другом. Магнитная восприимчивость свободных ионов Sm<sup>3+</sup>, рассчитанная по формуле [29]

$$\chi(\text{Sm}^{3+}) = \frac{\sum_{J=|L-S|}^{L+S} \{ [N_A g_J^2 \mu_B^2 J(J+1)/3kT] + \chi_{p,J} \} (2J+1) \exp\left(-\frac{\Delta}{kT}\right)}{\sum_J (2J+1) \exp\left(-\frac{\Delta}{kT}\right)},$$
(6)

приведена на рис. 2 в координатах  $\chi T(T)$  (линия 2). Учтены только два состояния — основное с J = 5/2 и  $g_{5/2} = 2/7 = 0.2857$  и первое возбужденное с J = 7/2 и  $g_{7/2} = 0.8254$ . Величина  $\Delta$  принята равной 1100 сm<sup>-1</sup> [30]. Значения  $\chi_{p,J}$  взяты из [31]. Видно, что при температурах ниже комнатной получившаяся зависимость практически линейна; следовательно, термическим заселением состояния  ${}^{6}H_{7/2}$  и экспоненциальными членами в (6) можно пренебречь и воспользоваться для расчета восприимчивости простой формулой (2), в которой первое слагаемое отвечает за ориентационную, а второе — за поляризационную восприимчивость. Для свободного иона Sm<sup>3+</sup> константа C = 0.0886 сm<sup>3</sup> · K/mol, что соответствует эффективному магнитному моменту иона  $\mu_{\rm eff} = 0.84 \,\mu_{\rm B}$ , а поляризационная ван-флековская восприимчивость при низких температурах составляет 6.76 · 10<sup>-4</sup> cm<sup>3</sup>/mol.

Таким образом, очевидно значительное количественное различие как между ориентационными, так и между поляризационными компонентами восприимчивости свободных ионов Sm<sup>3+</sup> и соединения SmCoO<sub>3</sub>. Во-первых, значение константы С дает для ионов Sm<sup>3+</sup> в SmCoO<sub>3</sub> значение эффективного магнитного момента  $\mu_{\rm eff} = 0.47 \,\mu_{\rm B}$  при температурах выше 20 К и только  $0.37 \mu_{\rm B}$  для температур меньших 10 K, что значительно ниже теоретического значения для свободного иона  $\text{Sm}^{3+}$ , равного  $0.84 \,\mu_{\text{B}}$ . Во-вторых, температурно-независимая компонента восприимчивости  $\chi_p$  для SmCoO<sub>3</sub> при высоких температурах примерно вдвое больше, чем для свободного иона и составляет 1.46 · 10<sup>-3</sup> против 0.676 · 10<sup>-3</sup> ст<sup>3</sup>/mol. При низких температурах T < 10 K эта компонента восприимчивости принимает еще более высокое значение:  $2.53 \cdot 10^{-3} \, \text{cm}^3$ /mol. Таким образом, видно, что ориентационный вклад в восприимчивость для ионов Sm<sup>3+</sup> в SmCoO<sub>3</sub> получается меньше, а поляризационный больше, чем в случае свободного иона.

Несмотря на то что ионы Co<sup>3+</sup> находятся в немагнитном состоянии и не дают вклада в ориентационную восприимчивость, поляризационная компонента восприимчивости для них может быть и не равна нулю. Если основное состояние иона немагнитно, а первое возбужденное обладает магнитным моментом, как в случае октаэдрически окруженного Co<sup>3+</sup>, ван-флековская компонента восприимчивости рассчитывается по формуле [26]

$$\chi(\text{Co}^{3+}) = \frac{N_{\text{A}}g^{2}\mu_{\text{B}}^{2}}{3kT} \frac{\nu S(S+1)(2S+1)\exp\left(-\frac{\Delta}{kT}\right)}{1+\nu(2S+1)\exp\left(-\frac{\Delta}{kT}\right)},$$
 (7)

где  $\nu$  — орбитальное вырождение возбужденного состояния. Проблема состоит в том, что для соединений LnCoO<sub>3</sub> порядок следования возбужденных уровней, а следовательно, и величины  $\Delta$  и  $\nu$  точно не определены. Оценки, проведенные в [26] на основе данных по магнитной восприимчивости, дали для LaCoO<sub>3</sub>  $\chi$ (Co<sup>3+</sup>) = 1.64 · 10<sup>-4</sup> cm<sup>3</sup>/mol, а для La<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>CoO<sub>3</sub> — еще меньшие значения. Ван-фле-

ковскую восприимчивость  $Co^{3+}$  в низкоспиновом состоянии можно также оценить по величине изотропной компоненты найтовского сдвига  ${}^{59}K_{\rm lso}$ , равной 2.11% для SmCoO<sub>3</sub> [20]. Соответствующая оценка дает  $\chi_p(Co^{3+}) \approx (4.3-4.6) \cdot 10^{-5}$  сm<sup>3</sup>/mol. Как видим, поправка невелика, и с ее учетом полученная нами ван-флековская восприимчивость ионов Sm<sup>3+</sup> в SmCoO<sub>3</sub> составляет  $(1.4 \pm 0.1) \cdot 10^{-3}$  сm<sup>3</sup>/mol в температурном интервале 20 < T < 320 K и  $(2.5 \pm 0.1) \cdot 10^{-3}$  сm<sup>3</sup>/mol при 4.2 < T < 10 K, что по-прежнему значительно больше величины, характерной для свободного иона.

Причиной этих различий является расщепление основного состояния иона Sm<sup>3+</sup> в кристаллическом поле. В перовскитоподобных кристаллах, таких как ортоферриты, ортохромиты и кобальтиты, редкоземельный ион находится в низкосимметричном лигандном окружении симметрии C<sub>s</sub> (искаженный кубооктаэдр). Поле такой симметрии расщепляет основной мультиплет иона Sm<sup>3+</sup> на три крамерсовских дублета. Как показано в [31], такое расщепление, во-первых, приводит к уменьшению магнитного момента атома ввиду влияния кристаллического поля на орбитальную компоненту. Эта особенность обычно рассматривается как "замораживание" орбитального момента, которое имеет место и в нашем случае. Во-вторых, влияние кристаллического поля может выражаться в сильной анизотропии g-фактора, намагниченности насыщения и восприимчивости кристалла. Для поликристаллических образцов мы имеем дело с усредненными величинами, и магнитная восприимчивость может быть вычислена как

$$\langle \chi \rangle = (\chi_{\parallel} + 2\chi_{\perp})/3,$$
 (8)

где  $\chi_{\parallel}$  и  $\chi_{\perp}$  — компоненты восприимчивости в направлениях, параллельном и перпендикулярном оси *z*. В предельном случае  $\chi_{\perp} = 0$ ,  $\langle \chi \rangle = \chi_{\parallel}/3$ , и наблюдаемые на опыте значения восприимчивости окажутся значительно ниже, чем для свободного иона. Возможно, что анизотропия также является фактором, препятствующим достижению магнитного насыщения в SmCoO<sub>3</sub>.

Как показано в [27,30,32], при расщеплении основного мультиплета иона Sm<sup>3+</sup> в поле различной симметрии основным, как правило, оказывается либо дублет с  $J_z = \pm 1/2$  и  $\mu_{\rm eff} = 0.25 \,\mu_{\rm B}$ , либо дублет с  $J_z = \pm 5/2$  и  $\mu_{\rm eff} = 1.24 \,\mu_{\rm B}$ . Наши данные указывают на то, что в кристаллическом поле симметрии  $C_s$  основным, скорее всего, является первый дублет, а величина расщепления порядка 10–11 К.

Ранее было обнаружено, что ван-флековская восприимчивость ионов  $Eu^{3+}$  в родственных соединениях  $La_{1-x}Eu_xCoO_3$  практически совпадает с восприимчивостью свободных ионов [26]. Дело в том, что основным состоянием  $Eu^{3+}$  является синглет  ${}^7F_0$ , J = 0, не претерпевающий расщепления в кристаллическом поле. В нашем случае это далеко не так. Таким образом, влияние кристаллического поля является очень значительным.

## 5. Заключение

Экспериментальное изучение статической намагниченности РЗМ-кобальтитов GdCoO3 и SmCoO3 показало, что при температурах ниже комнатной трехвалентные ионы кобальта в этих соединениях преимущественно находятся в немагнитном низкоспиновом состоянии. Намагниченность при этом в основном обусловлена магнитными моментами редкоземельных ионов Gd<sup>3+</sup> и Sm<sup>3+</sup>. В соединении GdCoO<sub>3</sub> наблюдается слабо выраженный антиферромагнетизм, возможно обусловленный нестехиометрией по кислороду, но в целом отклонения от чисто парамагнитного поведения не очень велики. Полученный в эксперименте эффективный момент Gd<sup>3+</sup> лишь на 7% ниже теоретического значения для свободного иона. Следовательно, в GdCoO3 магнитная система представляет собой совокупность слабовзаимодействующих ионов Gd<sup>3+</sup>, свойства которых близки к свободным ионам. Этого никак нельзя сказать о SmCoO<sub>3</sub>, в котором экспериментальное значение ориентационной компоненты магнитного момента Sm<sup>3+</sup> значительно ниже значения, характерного для свободного иона. Кроме того, в SmCoO<sub>3</sub> наблюдается ярко выраженный ван-флековский поляризационный парамагнетизм с восприимчивостью значительно большей, чем у свободных ионов. Такое резкое различие низкотемпературных магнитных свойств двух соединений близкого состава вызвано различием в строении их электронных оболочек. Gd<sup>3+</sup> является S-ионом с нулевым орбитальным моментом и симметричной электронной оболочкой. Поэтому его основное состояние практически не изменяется под действием кристаллического поля. В то же время основной мультиплет Sm<sup>3+</sup> в кристаллическом поле расщепляется на три крамерсовских дублета. Это приводит к частичному "замораживанию" орбитального момента и соответствующему уменьшению ориентационной компоненты магнитной восприимчивости. Ван-флековская компонента восприимчивости ионов  $Sm^{3+}$  в  $SmCoO_3$ , напротив, оказывается больше, чем для свободного иона, что указывает на большую поляризуемость электронной оболочки иона в кристаллическом поле.

#### Список литературы

- [1] G. Briceno, H. Chang, X. Sun, P.G. Shultz, X.-D. Xiang. Science **270**, 273 (1995).
- [2] C. Zobel, M. Kriener, D. Bruns, J. Baier, M. Gruninger, T. Lorenz. Phys. Rev. B 66, 020402 (2002).
- [3] R. Caciuffo, D. Rinaldi, G. Barucca, J. Mira, J. Rivas, M.A. Senaris-Rodrigues, P.G. Radaelli, D. Fiorani, J.B. Goodenough. Phys. Rev. B 59, 1068 (1999).
- [4] A. Maignan, V. Caignaert, B. Raveau, D. Khomskii, G. Sawatsky. Phys. Rev. Lett. 93, 026 401 (2004).
- [5] K. Berggold, M. Kriener, C. Zobel, A. Reichl, M. Reuther, R. Muller, A. Freimuth, T. Lorenz. Phys. Rev. B 72, 155116 (2005).
- [6] J.-W. Moon, W.-S. Seo, H. Okabe, T. Okawa, K. Koumoto. J. Mater. Chem. 10, 2007 (2000).

- [7] M. Kriener, M. Braden, D. Sneff, O. Zabara, T. Lorenz. Cond.mater. 0605721 (2006).
- [8] G. Thornton, F.C. Morrison, S. Partington, B.C. Tofield, D.E. Williams. J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 2871 (1988).
- [9] Y. Tokura, Y. Okimoto, S. Yamaguchi, H. Taniguchi, T. Kimura, H. Takagi. Phys. Rev. B 58, 1699 (1998).
- [10] Y. Morimoto, M. Takeo, X.J. Liu, T. Akimoto, A. Nakamura. Phys. Rev. B 58, 13 334 (1998).
- [11] Y. Takeda, H. Ueno, N. Imanishi, O. Yamamoto, N. Sammes, M.B. Phillips. Solid State Ionics 86–88, 1187 (1996).
- [12] C.R. Michel, A.S. Sago, H. Guzman-Colin, E.R. Lopes-Mena, D. Lardizabal, O.S. Buassi-Monroy. Mater. Res. Bull. 39, 2295 (2004).
- [13] S. Maekawa, T. Tohyama, S.E. Barnes, S. Ishihara, W. Koshibae, G. Khaliullin. Physics of transition metal oxides. Springer, N.Y. (2004), 331 p.
- [14] M. Medarde, C. Dallera, M. Grioni, J. Voigt, A. Podlesnyak, E. Pomjakushina, K. Conder, Th. Neisius, O. Tjernberg, S.N. Barilo. Phys. Rev. B 73, 054 424 (2006).
- [15] R.J. Radwanski, Z. Ropka. Cond.-mater. 0603619 (2006).
- [16] M.W. Haverkort, Z. Hu, J.C. Cezar, T. Burnus, H. Hartmann, M. Reuther, C. Zobel, T. Lorenz, A. Tanaka, N.B. Brookes, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, C.T. Chen, L.H. Tjeng. Cond.-mater. 0610457 (2006).
- [17] Н.Б. Иванова, Н.В. Казак, С.R. Michel, А.Д. Балаев, С.Г. Овчинников, А.Д. Васильев, Н.В. Булина, Е.Б. Панченко. ФТТ 49, 1427 (2007).
- [18] G. Demazeau, M. Pouchard, P. Hagenmuller. J. Solid State Chem. 9, 202 (1974).
- [19] K. Knizek, Z. Jirak, J. Hejtmanek, M. Veverka, M. Marysko, G. Maris. Phys. Rev. B 71, 054 420 (2005).
- [20] M. Itoh, M. Mori, S. Yamaguchi, Y. Tokura. Physica B 259–261, 902 (1999).
- [21] M. Itoh, J. Mashimoto, S. Yamaguchi, Y. Tokura. Physica B 281–282, 510 (2000).
- [22] C.J. Schinkel, W.D. van Amstel. Phys. Lett. 44A, 467 (1973).
- [23] R.M. Moon, W.C. Koehler. Phys. Rev. B 11, 1609 (1975).
- [24] I. Ardelean, E. Burzo, D. Mitulesku-Ungur, S. Simon. J. Non-Cryst. Sol. 146, 256 (1992).
- [25] E. Culea, A. Pop, I. Cosma. J. Magn. Magn. Mater. 157/158, 163 (1996).
- [26] J. Baier, S. Jodlauk, M. Kriener, A. Reichl, C. Zobel, H. Kierspel, A. Freimuth, T. Lorenz. Phys. Rev. B 71, 014 443 (2005).
- [27] А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Мир, М. (1972). Т. 1. 651 с.
- [28] M.M. Abraham, L.A. Boatner, C.B. Finch, E.J. Lee, R.A. Weeks. J. Phys. Chem. Sol. 28, 81 (1967).
- [29] С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с.
- [30] G.F. Goya, R.C. Mercader, M.T. Causa, M. Tovar. J. Phys.: Cond. Matter 8, 8607 (1996).
- [31] А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 294 с.
- [32] S.K. Misra, Y. Chang, J. Felsteiner. J. Phys. Chem. Sol. 58, 1 (1997).